



Toshiba Memory Europe introduce la soluzione di memoria di classe storage XL-FLASH

La memoria NAND con le massime prestazioni sul mercato offre inoltre una latenza ridotta ed è più economica

Düsseldorf, Germania, 5 Agosto 2019 – Toshiba Memory Europe GmbH (TME) ha annunciato oggi il lancio di una nuova soluzione di memoria di classe storage (SCM): XL-FLASH™. Basata sull'innovativa tecnologia di memoria flash 3D BiCS FLASH™ con architettura SLC a 1 bit per cella, la XL-FLASH offre una latenza ridotta e prestazioni elevate per i data center e per lo storage aziendale.

Classificata come SCM (o memoria persistente), con la possibilità di conservare il proprio contenuto analogamente ad una memoria flash NAND, la XL-FLASH colma il divario di prestazioni che esiste tra le memorie DRAM e le NAND. Benché le soluzioni di memoria volatili come la DRAM forniscano la velocità di accesso richiesta dalle applicazioni più esigenti, tali prestazioni sono ottenute a fronte di un costo elevato. Con il costo per bit e la scalabilità delle DRAM che si stanno progressivamente stabilizzando, questo nuovo strato SCM all'interno della gerarchia di memoria risolve il problema con una soluzione di memoria flash NAND ad alta densità, economica e non volatile. La società di analisi di mercato IDC prevede che il mercato delle soluzioni SCM è destinato a crescere fino a oltre 3 miliardi di dollari nel 2022^[1].

Posizionandosi a metà strada tra una DRAM e una flash NAND flash, la XL-FLASH offre una maggiore velocità, una latenza ridotta e una capacità di archiviazione più elevata - a un costo inferiore rispetto ad una DRAM tradizionale. Le memorie XL-FLASH saranno inizialmente distribuite in formato SSD, ma la tecnologia potrebbe essere estesa ai dispositivi collegati al canale di memoria che risiede sul bus DRAM, oltre ai futuri moduli standard duali non volatili di memoria in linea (NVDIMM).

Caratteristiche principali

- **die da 128 gigabit (Gb)** (in un package a 2 die, 4 die o 8 die)
- **Dimensioni di 4 kB per pagina** per operazioni più efficienti di lettura e scrittura del sistema operativo
- **Architettura a 16 piani** per un parallelismo più efficiente
- **Lettura rapida delle pagine e tempi di programmazione ridotti.** La XL-FLASH offre una bassa latenza di lettura, pari a meno di 5 microsecondi, ed è circa 10 volte più veloce rispetto alle memorie TLC esistenti^[2].

In qualità di inventore delle memorie NAND flash, oltre ad essere la prima azienda ad aver annunciato la tecnologia di memoria flash 3D e ad essere leader nelle migrazioni di processi, Toshiba Memory si trova nella posizione ideale per fornire soluzioni SCM basate su architettura SLC con processi produttivi evoluti, una scalabilità collaudata e un'affidabilità dell'architettura SLC comprovata nel tempo.

“XL-FLASH è la memoria NAND con le massime prestazioni disponibili sul mercato, grazie alla nostra tecnologia BiCS FLASH – usata in modalità SLC,” ha osservato Axel Stoermann, Vice Presidente di Toshiba Memory Europe GmbH. “Memorizzando un solo bit per cella, siamo in grado di aumentare considerevolmente le prestazioni. Inoltre, essendo la memoria XL-FLASH basata su tecnologie collaudate che produciamo già in volumi, i nostri clienti saranno in grado di accelerare il time-to-market con l'adozione della XL-FLASH come soluzione di memoria di Classe Storage.”

Le consegne dei campioni avranno inizio a Settembre 2019, con la produzione in volumi prevista per il 2020.

Note:

[1] IDC Maggio 2019 - Previsione sulle unità di memoria allo stato solido a livello mondiale, 2019-2023, Doc - US43828819

[2] Rispetto alla memoria NAND TLC di TMC che presenta una latenza in lettura di circa 50 microsecondi.

L'affermazione “memoria NAND con le massime prestazioni disponibili sul mercato” è basata sul fatto che il die è stato specificamente progettato (a 16 piani) per fornire prestazioni più elevate rispetto alle memorie NAND TLC.

Tutti i nomi delle società, le denominazioni dei prodotti e le designazioni dei servizi potrebbero essere marchi registrati delle rispettive aziende.

Nei prodotti di Toshiba Memory qui menzionati: La densità del prodotto è identificata in base alla densità del chip (o dei chip) di memoria all'interno del Prodotto, e non alla quantità di capacità di memoria disponibile per la memorizzazione dei dati da parte dell'utente finale. La capacità utilizzabile dai consumatori sarà inferiore a causa della presenza di aree di sovraccarico dei dati, della formattazione, di blocchi danneggiati e di altri vincoli, e potrebbe anche variare in base al dispositivo host e all'applicazione. Per maggiori dettagli, fate riferimento alle specifiche di prodotto applicabili. La definizione di 1 Gb = 2^{30} bit = 1.073.741.824 bit. La definizione di 1 GB = 2^{30} byte = 1.073.741.824 byte. La definizione di 1 KB = 2^{10} byte = 1.024 byte.

###

Informazioni su Toshiba Memory Europe

Toshiba Memory Europe GmbH (TME) è la divisione europea di Toshiba Memory Corporation (TMC). La nostra azienda offre un'ampia linea di prodotti di memoria flash di alta fascia, fra cui schede SD, supporti USB, micro SD e componenti di memoria embedded, oltre alle unità disco allo stato solido (SSD). TME dispone di uffici in Germania, in Francia, Spagna, Svezia e nel Regno Unito. Il Presidente dell'azienda è Masaru Takeuchi.

Per ulteriori informazioni sulla gamma completa di prodotti di memoria e di SSD di TME visitate business.toshiba-memory.com

Contatti per la pubblicazione:

Toshiba Memory Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549, D-40549 Düsseldorf, Germania

Tel: + 49 (0) 211 368 77-0 Fax: + 49 (0) 211 368 774 00

E-mail: support@toshiba-memory.com

Contatti per richieste editoriali:

Sandrine Aubert, Toshiba Memory Europe GmbH

Tel: +49 (0) 211 36877 579

E-mail: SAubert@toshiba-tme.eu

Pubblicato da:

Birgit Schöniger, Publitek

Tel: +44 (0) 20 8429 6554

E-mail: birgit.schoeniger@publitek.com

Web: www.publitek.com

Rif. TME035A_ITA